全フッ素化ポリイミド光学材料とその光導波路への適用

(NTT) ○松浦 徹、栗原 隆、丸野 透、小林 潤也
(NTT-AT) 川田 久美子、川上 直美、工藤あや子、山本 二三男
((株) 日本触媒) 後藤 伸一、田尻 浩三、浅子 佳延

1. はじめに

光通信の普及に伴い、低コストで高性能な光部品のための高分子材料が求められている。NTTで はポリイミドの分子内のC-H結合を全てC-F結合に置き換えた全フッ素化ポリイミド(10FEDA/ 4FMPD)を開発してきた[1]。これは近赤外の光通信波長で光吸収の要因となるC-H結合をなくし、 同波長で優れた光透過性を有する耐熱性高分子材料である。本研究では上記材料に屈折率制御性 を付与した全フッ素化ポリイミド光学材料(FLUP1-PF)を用いて埋め込み型光導波路を作製し、 その導波路材料としての特性を評価するとともに光導波路への適用性を検討した。

2. 全フッ素化ポリイミド材料

本研究に用いたFLUPI-PFの分子構造を図1 に示す。図中左側の10FEDA/4FMPDを基本骨格 とし、これに屈折率制御性を付与するために、 屈折率の高い屈折率制御基Rfを添加した。

表1にRfを含まない最も屈折率の低いク ラッド用全フッ素化ポリイミド(FLUPI-PF-

01)、Rfを50モル%添加した 高屈折率ポリイミド(FLUPI-PF-55)、及び比較材料とし て、6FDAとTFDB(2,2'bistrifluoromethyl-4,4'-

diaminobiphenyl)から合 成した既存の部分フッ素化ポ リイミド(FLUP1-CB-01)の 基本的特性を示す。全フッ素 化ポリイミドは耐熱性(熱分 解温度Td、ガラス転移温度 Tg)が既存のFLUP1-CBと比べ

て若干低いもののポリイミド特有の300℃以上 の優れた耐熱性を示している。また、熱膨張係 数(CTE)、屈折率(n_{TE} 、 n_{TI})、複屈折(n_{TE} $= n_{TI}$)は既に光導波路材料として適用中の FLUP1-CBとほぼ同様の特性値を有する。図2に Rfの添加量を変えたときのFLUP1-PFの屈折率 と複屈折を示す。Rfの添加量を調節することで 屈折率を精密に制御できることがわかる。ま た、FLUP1-PFの複屈折($n_{TE} - n_{TI}$)はRfの添 加に寄らずほぼ一定であり、かつその値はポリ イミド材料としては0.008と比較的小さく、光 導波路用材料として適用し易い。

3. 光導波路の作製と特性

前記屈折率の異なる2種類の材料をコアとク



Fig. 1 Structure of perfluorinated polyimides (FLUPI-PF)

Table I

I Fundamental properties of FLUPI-PF

Polyimides	Rf content (mol%)	Td (℃)	Tg (℃)	CTE (ppm)	n _{TE}	n _{TN} n _{TE} - n _{TN}
FIJUPT-PF-01	0	501	301	56	1. 521	1.513 0.008
FLUP1-PF-55	50	479	317	59	1.525	1.517 0.008
FLUPT-CB-01 (P.	artially fluorinated)	569	335	63	1.517	1.509 0.008

Td: Decomposition Temperature, 10% weight Loss in $N_{\rm 2}$ Atmosphere Table 01 $\,$

Tg: Glass transition Temperture

CTE: Coefficient of thermal expansion, temperature range: 50 - 200°C

 $n_{TE};$ In-plane refractive index $~n_{TM};$ Out-of-plane refractive index at 1550 nm n_{TE} - $n_{TM};$ Birefringence



Fig. 2 Refractive index of FLUPI-PF

ラッドに用いてシリコン(Si) 基板上に埋込型直線光導波路を作製した。4インチSi 基板上にクラッド用及びコア用ポリアミド酸溶液を順次スピンコートと熱処理することで下部クラッド層とコ

ア層を形成した。コア層は既存のフォトリソグラフィ と酸素の反応性イオンエッチングにより直線のリッジ を形成した。最後に上部クラッド用ポリアミド酸溶液 をスピンコートし熱処理することで埋込型光導波路が 作製できた。(図3)

図4に作製した埋込型直線光導波路に波長の異なる 光を入射したときの出射光のニアフィールドパタン (NFP)を示す。波長1.3及び1.55 µmでの出射光の強 度分布はコア中心が最も強いガウス分布にほぼ一致し ており、本光導波路がシングルモードであることがわ かる。一方、波長0.85 µmでは出射光が大きく分かれ、 0次と1次モードが伝搬するマルチモード光導波路と なっている。

作製した埋込型直線光導波路の損失 の波長依存性を図5に示す。FLUPI-PF 材料では近赤外波長に明確な吸収はな いが、作製した光導波路では波長1.4 μ m付近に広幅で低い吸収、及び1.4と 1.65 μm付近に狭幅の吸収が見られ、 これは光が長い距離(5cm)を導波する 過程で光導波路作製時に付着した水分 や不純物、または微量の残留溶媒等に よって吸収されたものと考えられる。 しかし、材料に FLUP I-PFを採用するこ とで、波長1.3から1.5 µ m以上の領域 では既存の部分フッ素化ポリイミド (FLUPI-CB)[2]を用いた場合と比較し て、低損失であり、特に1.5μm帯の幅 広い波長範囲で低損失を有している。

直線光導波路の導波損失と接続損失 を詳細に調べるためにカットバック法 により損失を評価した。図6に波長 1.55μm、TEモードでの測定結果を示 す。図のプロットの傾きよりこの直線 光導波路の導波損失は0.10dB/cm、接続 接続損失は0.54dBと求められた。同様 の手法によりTMモード、及び波長1.3 μmでの評価結果、さらに比較として 既存のFLUPI-CBから作製した光導波路 の導波損失の評価結果を表2にまとめ た。ポリイミドの分子構造の全ての水 素(H)を除去することで、波長1.55



Fig. 3 Cross-sectional micrograph of buried waveguide





FLUPI-PF (Perfluorinated polyimide) FLUPI-CB (Pertially fluorinated polyimide)



Fig. 5 Loss spectra for waveguides of FLUPI-PF and FLUPI-CB

μmにおいて特に顕著に導波損失を 低減できた。また、1.3と1.55μmの 両波長で0.1dB/cm台の極めて低い導 波損失を示し、その偏波依存損失(TE とTMモードの損失の差)も0.1dB/cm 未満であった。本材料は導波路長が 長く複雑な光回路を有する部品や、 より低損失性を要求される光導波路 部品に用いる材料として有用と考え られる。

次に本光導波路を実用的な光回路 に適用するために、曲率の異なる 種々の90度の曲線光導波路を作製し た。図7に曲線導波路の曲率半径と 曲げ損失の増加の関係を示す。この 結果より波長1.55 µmで使用する場 合には光回路の曲率を約10mm以上に 設定すれば、曲げ損失は生じない(最 小曲げ半径は約10mmである)ことが わかった。この結果は同等のコア/ クラッド屈折率差を有する既存の FLUPI-CB光導波路や石英光導波路の 特性とほぼ一致した。

4. 光導波路部品への適用

前記 FLUPI-PF 光導波路は近赤外、 特に1.5μm帯の幅広い波長範囲で 低損失を有することから、波長間隔 の広いCoarse Wavelenth Division Waltiplexer (CWDM)への適用を検討 した。

作製した CWDM は波長間隔 40nm の 4 チャネル CWDM (4ch-CWDM) であ る。使用波長は 1.55 μ m帯において ITU-T 規格で標準化された 20nm 間隔 の各波長の中で、FLUPI-PF 光導波路 の低損失領域に入り、かつ 1 波長飛 びの 1470、1510、1550、1590nm に設 定した。概略と CWDM チップ部の写真 を図 8 に示す。Si 基板上に Y 分岐光 導波路を作製して 3 カ所の分岐部に





Table II Transmission losses for waveguide of FLUPI-PF and FLUPI-CB

	Wave length	D. I. J. J.	Loss (diB/cm)			
	(µm)	Polarization	FLUP1-PF	FLUP1-CB		
Γ	1 55	TE	0.1	0. 5		
	1.00	TM	0. 18	0. 6		
	1.2	TE	0. 11	0. 3		
	1.3	TM	0. 15	0.4		



Fig. 7 Transmission losses of buried waveguide at 1.55 μ m for TE polarization

対応する3枚の誘電体多層膜フィルタを挿入し、光導波路の入出射端面にSCコネクタ付光ファイ バアレイを光学接着剤を用いて接続した。これをプラスチックパッケージに実装することで4ch-CWDMモジュールを作製した。

この4ch-CWDMの多重光ポートから白色 光を入射し、各波長ポートからの出射光を スペクトルアナライザで受光した時の各 ポートの波長スペクトルを図9に示す。

この図より多重化光の合波ポートから入 射した白色光が設計した 4 波を中心として ほぼ設計通りに分波され、各出力ポートよ り出射していることがわかる。さらに各設 計(使用)波長において、LD とパワーメー タを用いて測定した入出射コネクタ間の挿 入損失は波長1470 nmで4.8dB、波長1510 nmで5.0dB、波長1550 nmで4.8dB、波長 1590 nm で 2.6dB であり、隣接チャネル間 のクロストークは-17 dB以下であった。 これらの損失は既存のFLUPI-CBを用いた 同仕様の4ch-CWDMの損失6.8 dB以下[3] と比較して約2 dB程度低い値を示した。 特に波長1590 nmでは挿入損失2.6 dBと 極めて低い値を示したが、これは FLUP I-PF 光導波路の波長1590 nmでの導波損失が他 の波長より低いことと本4ch-CWDMにおい て波長1590 nmの光の導波長が最も短いこ との相乗効果による。従って、今後各波長 での導波損失とCWDMチップ内での導波路 長の組合わせを最適化し、光回路を再設計 することで、損失ばらつきを抑制し、より 平均化することも可能と考えられる。

4. まとめ

近赤外の光通信波長の幅広い波長領域で 優れた光透過性と屈折率制御性を有する全 フッ素化ポリイミド(FLUPI-PF)を合成し









た。この材料を用いた埋込型光導波路は波長1.3及び1.55μmでシングルモードであり、0.1dB/ cm台の低損失性を示した。またこの光導波路の1.5μm帯での幅広い範囲での低損失性を利用し て波長間隔40nmの4ch-CWDMを作製した。このCWDMは既存の部分フッ素化ポリイミド(FLUPI-CB)を用いた CWDM より低挿入損失であり、FLUP I-PF の光通信用部品への適用性を示す結果と考

文献

[1] S. Ando, T. Matsuura, and S. Sasaki, *Macromolecules*, **25**(21), 5858(1992)

[2] T. Matsuura, S. Ando, S. Sasaki, and F. Yamamoto, Macromolecules, 27 (22), 6665

[3] 川上,小林、工藤,景井、疋田、今村郎、山本、電子情報通信学会総合大会、C-3-149, 2002

ポリイミド・芳香族系高分子 最近の進歩 2004